

03;04;07;11

©1995

**ТОНКАЯ СТРУКТУРА
ПРИ ЭЛЕКТРОДНЫХ ОБЛАСТЕЙ XeCl
РАЗРЯДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ**

M.K. Макаров

Трудность однородного формирования электрического газового разряда высокого давления так или иначе связана с неустойчивостью катодного слоя. Неизбежность пространственных нарушений такого рода является следствием неоднородности электронной эмиссии с поверхности катода [1,2]. В случае эксимерного XeCl разряда хорошо известно явление множественного формирования катодных пятен, когда приэлектродная область оказывается пронизанной опирающимися на них тонкими сильноточными каналами [5]. Одним из очевидных решений проблемы является искусственное создание таких условий, при которых поверхностная плотность локальных эмиссионных центров на катоде была бы достаточно высока и диффузные каналы, перекрываясь, образовывали бы квазиоднородный столб плазмы. Однако большинство предлагаемых способов (спецполировка рабочих поверхностей, графитовое напыление, использование плазменных электродов и т.д.) оказываются малопригодными с практической точки зрения.

В этой связи обращает на себя внимание тонкая структура слаботочного XeCl разряда, формирующаяся вблизи анода при колебательном режиме накачки (рис. 1). На рис. 2 представлены интегральные фотографии такого разряда в типичной эксимерной газовой смеси $\text{Ne}/\text{Xe}/\text{HCl}=1000/10/1$, $p = 2$ атм. Разряд с плотностью тока $j \sim 30 \text{ A/cm}^2$ зажигался между двумя плоскими алюминиевыми электродами, один из которых (на снимках нижний) был полупрозрачен для рентгеновского излучения предионизации (доза $D \sim 2-5 \text{ мР/импульс}$, $t_{\text{имп}} \sim 20 \text{ нс}$). Глубина промежутка составляла $d = 3.5 \text{ см}$, площадь поперечного сечения активной области — $S \sim 25-30 \text{ см}^2$. Питание разряда происходило от керамического конденсатора, коммутируемого непосредственно на промежуток. Предварительная ионизация среды осуществлялась после подачи высокого напряжения [3].

На фотографиях рис. 2 хорошо заметно узкое ($\sim 0.07 \text{ см}$) резко очерченное темное пространство вблизи верхнего

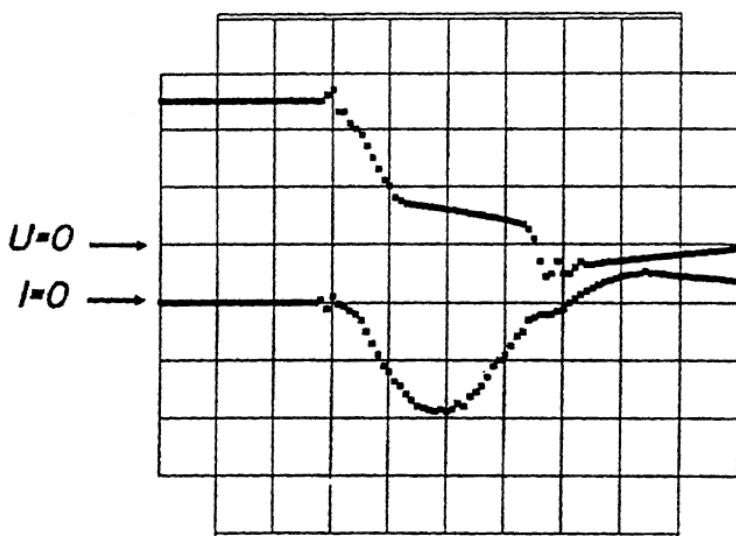
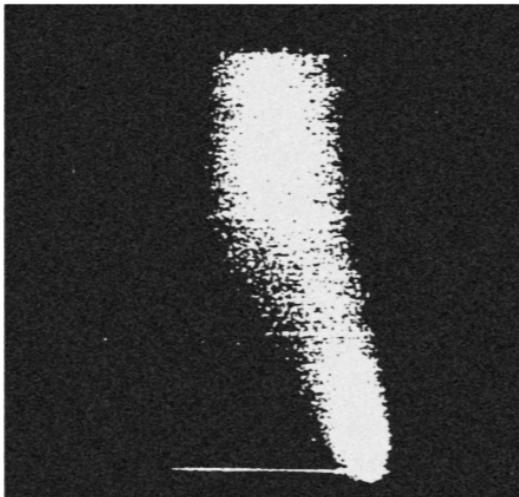


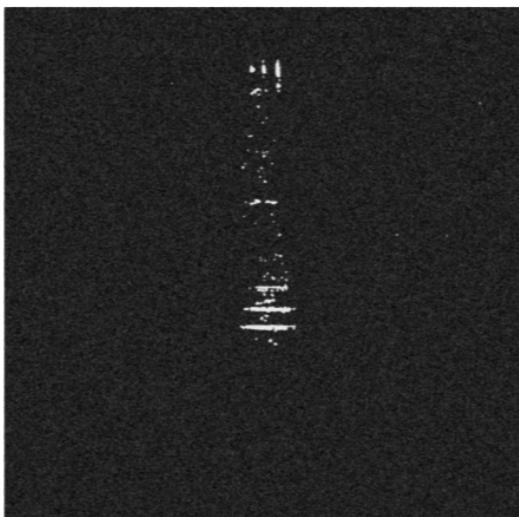
Рис. 1. Типичные осциллограммы тока разряда и напряжения на плазме. $C = 1.5 \text{ нФ}$; шкалы — $\Delta t = 100 \text{ нс/дел}$, $\Delta U = 6 \text{ кВ/дел}$, $\Delta i = 50 \text{ А/дел}$.

электрода (катод после смены полярности), однородно заполненное большим количеством тонких каналов. Если образование темной области происходит в результате дрейфа электронов после смены полярности электродов, электрическое поле на аноде должно быть достаточно велико. В данном случае в качестве завышенной оценки длительности переходного периода можно принять величину $\delta t \sim 10 \text{ нс}$. Тогда, исходя из размеров темной зоны, дрейфовая скорость электронов должна составлять $v_d \sim 0.07 \text{ см}/10 \text{ нс} \sim 7 \cdot 10^6 \text{ см/с}$, что соответствует полю в слое $(E/p)_k \sim 4 \text{ кВ}/(\text{см} \cdot \text{атм})$. При этом средняя напряженность электрического поля в плазме не превышает величины $E/p \sim 0.1\text{--}0.2 \text{ кВ}/(\text{см} \cdot \text{атм})$ и, что особенно важно, никаких специальных требований к качеству поверхности электрода не предъявляется. Для сравнения: в [5] аналогичная картина вблизи тщательно отполированного катода наблюдалась при среднем поле $E/p \sim 4.5 \text{ кВ}/(\text{см} \cdot \text{атм})$ и длительности фронта импульса напряжения $t_f < 10 \text{ нс}$.

Единственным, но, на наш взгляд, решающим отличием описываемой ситуации от традиционной является тот факт, что формирование тонкой структуры начинается при средней концентрации электронов в промежутке $N_e \sim 10^{13} \text{ см}^{-3}$, а не при типичном уровне предионизации $N_{e0} \sim 10^8 \text{ см}^{-3}$. Можно легко показать, что с ростом "стартовой" концентрации электронов сокращается глубина дрейфового пространства. Действительно, в этом случае накопление объемного заряда в прикатодной области будет идти быстрее



α



β

Рис. 2. Интегральные фотографии слаботочного ($j \sim 30 \text{ A/cm}^2$) XeCl разряда при колебательном режиме возбуждения. а — $C = 1.5 \text{ нФ}$, б — $C = 3 \text{ нФ}$.

и компенсация внешнего электрического поля, вызывающего первоначальный дрейф электронов, наступит раньше, на меньшем расстоянии от катода. С другой стороны, на несколько порядков большая, нежели в традиционном случае, концентрация положительных ионов вблизи поверхности катода приводит к значительному усилению вторичной электронной эмиссии и улучшению ее однородности. Наконец, более мощный поток энергетических фотонов из объема (как благодаря увеличению концентрации возбужденных атомов Xe, так и за счет сокращения глубины темного пространства) усиливает фотоэмиссию с катода. Все это в целом и приводит к значительно более плотному и однородному заполнению каналами дрейфового пространства.

Правомерен вопрос об использовании наблюдаемого явления для формирования однородного разряда накачки XeCl лазеров. Что касается слаботочного XeCl разряда ($j \sim 1-30 \text{ A/cm}^2$), то его зажигание не представляет проблемы [6]. Принципиально устойчивый, он элементарно формируется в любых начальных условиях и при любой конфигурации электродной системы. При этом энергетические затраты на его поддержание несущественны. Переход затем в сильноточную рабочую фазу накачки также возможен. Разработанные к настоящему времени схемы с магнитной изоляцией [7] позволяют достаточно просто реализовать режим со сменой полярности электродов и согласованным вводом в плазму запасенной энергии.

Список литературы

- [1] Месяц Г.А. // Письма в ЖТФ. 1975. Т. 1. В. 14. С. 660–663.
- [2] Королев Ю.Д., Месяц Г.А. // Физика импульсного пробоя газов. М.: Наука, 1991. 223 с.
- [3] Макаров М.К. // J. Phys. D: Appl. Phys. 1995. V. 28. N 6. P. 1083–1093.
- [4] Канатенко М.А. // Письма в ЖТФ. 1983. Т. 9. В. 4. С. 214–218.
- [5] Bötticher W., Lück H., Niesner St., Schwabedissen A. // Appl. Phys. B. 1992. V. B54. P. 295–302.
- [6] Bychkov Yu.I., Kostyrya I.D., Makarov M.K., Suslov A.I., Yastremski A.G. // Rev. Sci. Instrum. 1994. V. 65. N 4. P. 793–798.
- [7] Taylor R.S.// Appl. Phys. B. 1994. V. B59. P. 479–508.

Институт сильноточной
электроники
СО РАН
Томск

Поступило в Редакцию
14 июля 1995 г.